

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P2003, 0834WO	WEITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT/ISA/220 sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/002603	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 24/11/2004	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 28/11/2003
Anmelder OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH		

Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der Internationalen Recherchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Büro übermittelt.

Dieser internationale Recherchenbericht umfaßt insgesamt 4 Blätter.

☒ Darüber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.

1. Grundlage des Berichts

a. Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der Internationalen Anmeldung in der Sprache durchgeführt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

☐ Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behörde eingereichten Übersetzung der Internationalen Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt worden.

b. ☐ Hinsichtlich der in der Internationalen Anmeldung offenbaren Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz siehe Feld Nr. 1.

2. ☐ Bestimmte Ansprüche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld II).

3. ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld III).

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung

☐ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☒ wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:

**WÄRMESENKE FÜR EINEN GEPULSTEN LASERDIODENBARREN MIT OPTIMIERTER
THERMISCHER ZEITKONSTANTE**

5. Hinsichtlich der Zusammenfassung

☒ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.

☐ wurde der Wortlaut nach Regel 36.2b) in der in Feld Nr. IV angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.

6. Hinsichtlich der Zeichnungen

a. ist folgende Abbildung der Zeichnungen mit der Zusammenfassung zu veröffentlichen: Abb. Nr. 1

☒ wie vom Anmelder vorgeschlagen

☐ wie von der Behörde ausgewählt, weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.

☐ wie von der Behörde ausgewählt, weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet.

b. ☐ wird keine der Abbildungen mit der Zusammenfassung veröffentlicht.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/002603

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H01S5/024

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H01S H01L

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ, INSPEC, COMPENDEX, IBM-TDB

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 978 396 A (DUCHEMIN ET AL) ✓ 2. November 1999 (1999-11-02)	1-7, 11-15
Y	Spalte 3, Zeilen 4-36; Abbildungen 2-4,9 Spalte 4, Zeilen 13-15,63-67 Spalte 5, Zeilen 9-46	8-10
X	ENDRIZ J G ET AL: "HIGH POWER DIODE LASER ARRAYS" IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, IEEE INC. NEW YORK, US, Bd. 28, Nr. 4, 1. April 1992 (1992-04-01), Seiten 952-965, XP000272686 ✓ ISSN: 0018-9197	1,6-12
Y	Seite 956, rechte Spalte Seite 959, linke Spalte; Abbildung 17 ----- -/-	8-10



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definieren, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E Ältestes Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

15. Februar 2005

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

23/02/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2,
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Laenen, R

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/002603

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beitr. Anspruch Nr.
X	<p>PUCHERT R ET AL: "Influence of the mounting configuration on the transient thermal behavior of high power laser diode arrays"</p> <p>ELECTRONIC COMPONENTS AND TECHNOLOGY CONFERENCE, 1997. PROCEEDINGS., 47TH SAN JOSE, CA, USA 18-21 MAY 1997, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 18. Mai 1997 (1997-05-18), Seiten 1254-1259, XP010234002 ISBN: 0-7803-3857-X das ganze Dokument</p>	1,7,11, 12,14
X	<p>US 2002/006146 A1 (MCMINN THEODORE S ET AL) 17. Januar 2002 (2002-01-17) Absätze '0062! - '0066!; Abbildungen 7,9</p>	1,7,14
X	<p>PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 013, Nr. 103 (E-725), 10. März 1989 (1989-03-10) & JP 63 276286 A (NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>), 14. November 1988 (1988-11-14) Zusammenfassung</p>	1,7,14
X	<p>US 6 449 295 B1 (OSTROMEK TIMOTHY EVERETT) 10. September 2002 (2002-09-10) Spalte 2, Zeile 23 - Spalte 4, Zeile 8; Abbildungen 1,2</p>	1,7,11, 12,14

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/002603

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5978396 A	02-11-1999	FR 2736764 A1	17-01-1997
		DE 69624209 D1	14-11-2002
		DE 69624209 T2	10-07-2003
		EP 0781463 A1	02-07-1997
		WO 9703487 A1	30-01-1997
		JP 10507318 T	14-07-1998
US 2002006146 A1	17-01-2002	US 6272164 B1	07-08-2001
		US 6144684 A	07-11-2000
		US 5734672 A	31-03-1998
		DE 69710002 D1	14-03-2002
		DE 69710002 T2	18-07-2002
		EP 0823759 A2	11-02-1998
		IL 121485 A	26-07-2000
		JP 3384950 B2	10-03-2003
		JP 10190134 A	21-07-1998
		JP 2001203418 A	27-07-2001
JP 63276286 A	14-11-1988	JP 2582368 B2	19-02-1997
US 6449295 B1	10-09-2002	EP 1238447 A1	11-09-2002
		WO 0139338 A1	31-05-2001